Japanese

JP 1986-278820 19861125
The diphenic acid monoester soldering flux is used on printed-circuit boards for easy cleaning with freon 113. The monoester is C3-18 alkyl monoalkyl ester. Thus, a soldering flux soln. contg. 30% diphenic acid monoiso-Pr ester and polymd. rosin in iso-PrOH was used in soldering an oxidized Cu plate using a soldering wire by heating at 260.degree. The solder was spread at 96%, and elec. resistivity of iso-PrOH and tap water mixt. after extg. the soldered board cleaned with freon was 11.4 .times. 105 .OMEGA.-cm, compared with 89% and 6.5 .times. 105 .OMEGA.-cm for the polymd. rosin soln.

27428-72-4 117354-45-7

RL: USES (Uses) (soldering fluxes contg., for printed-circuit boards for easy cleaning with freon)

RN 27428-72-4 CAPLUS
CN [1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarboxylic acid, monobutyl ester (9CI) (CA INDEX NAME)

IT

RN 117354-45-7 CAPLUS CN [1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarboxylic acid, mono(1-methylethyl) ester (9CI) (CA INDEX NAME)

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-132795

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)6月4日

B 23 K 35/363

A-6919-4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称

ハンダフラツクス

②特 願 昭61-278820

②出 願 昭61(1986)11月25日

切発明者 古野

惠 神奈川県川

神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目3番1号 旭化成工業株

式会社内

切発 明 者 伊藤

征男

神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目3番1号 旭化成工業株

式会社内

⑪出 願 人 旭化成工業株式会社

②代理 人 弁理士 清水 猛

大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

明 網 🕿

1 発明の名称

ハンダフラツクス

2 特許請求の範囲

(II) ジフェン酸モノエステルからなることを特象とするハンダ付け用フラックス。

(21シフェン酸モノエステルが炭素数 5 ~ 1 8 の アルキル基のモノアルキルエステルである特許請 求の範囲第1項記載のハンダ付け用フラックス。

5 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ハンダ付けを行なり際に使用するフラックスに関する。

(従来の技術)

従来よりハンダ付けを行かり際に、金属表面の 酸化物皮膜を除去し、ハンダの付着性を改 する ために用いられるフラック-スには、大別して無极 系と有機系の化合物がある。

無根系には塩酸、燐酸等の無機酸、塩化亜鉛、

塩化アンモニウム等の無機塩があるが、とれらは 腐蝕性が大きく、ハンダ付け後の水洗処理が必要 である。したがつて、水洗を行ないにくい電子部 品搭載のブリント回路基板用には随度が多い。

有機系には乳酸、ステアリン酸等の有機酸、ジエチルアミンやプロピルアミン等の各種アミンの. ハロゲン酸塩、ロジン等の樹脂がある。有機酸や アミンのハロゲン酸塩は、無根系よりは程度が低 いにしても、やはり腐蝕性があり、フラックスの 補助成分として少量用いる他は、一般にハンタ付 け後に洗浄する必要がある。また、この場合の洗 **浄剤には、框性の高いものが要求される等の制限** が多い。ロジン系は金属酸化物を溶解する能力 (以下、フラックス活性という)が弱いという欠 点があるが、腐蝕性が低い、電気砲暴性がよい等 の点で、特にブリント回路基板へのハンダ付けに 多用されている。ロジン系フラツクスの場合、そ の特性から、ハンダ付け役に洗浄が省略される場 合が多い。しかし、コンピューチー、通信被等の 産業機器で高度の信頼性が要求される分野では、

やはりハンダ付け後にフラックス成分は洗浄除去 されなければならない。

(発明が解決しようとする問題点)

フラックスの洗浄剤としては、水の他に、エタノールやイソプロパノール等のアルコール類、メチレンクロライドやメチルクロロホルム等の塩素化炭化水素類、1.1.2 - トリクロロー 1.2.2 - トリフルオロエタン(以下、フロン 1 1 5 と称す)等の弗素系炭化水素類が使われる。

近年、各種部品を搭載したブリント回路基板を 丸どと洗浄する場合、搭載部品への影響が少ない と、 職燃性であること、 毎性が低いこと、 廃 での処理が簡単であること等から、 フロン 1 1 3 を 洗浄剤として使用したいという要望が高い。 し、従来のフランクスは、 フロン 1 1 3 で洗浄して にくいという欠点がある。その中でロジン系フラ ツクスは、 フロン 1 1 3 で洗浄しやすう 知に属するが、 それでも洗浄性が充分でなく、 フロン 1 1 3 にアルコール類を混合したもので洗浄

本発明のフラックスは、通常、ジアのなインプロペノール等ののするとにおいて1~40分溶解するとになった。これにエチルアブロックスは、カーシャアミン、インス・インス・インス・インス・インス・クロックスが、クロックスが、クロックスが、クロックスが、クロックスが、クロックスが、クロックスが、クロックスが、クロックスが、クロックスが、クロックスが、クロックスが、クロックスが、クロックスが、クロックスが、クロックスが、クロックスが、クロックスが、からのである。また、ののである。また、ののである。

本発明のフラックスをブリント回路基板に適用 するときは、刷毛、スプレー、 浸漬盘布法等の一 紋的方法が可能である。

(実施例)

以下に、実施例によって本発明の効果を示す。 なお、実施例に示す試験は次の方法によって行な われる。 する等の必要があり、使用上の制限が多い。

(問題点を解決するための手段)

本発明者らは、このような状況に鑑み、フラックス活性が高く、フロン113単独で容易に洗浄できるハンダ付け用フラックスを得ることを目的として、 種々検討を行なつた結果、目的に適うフラックス組成物を見出し、本発明に到達した。

すなわち、本発明は、シフェン酸モノエステルからなることを特徴とするハンダ付け用フラックスである。好ましくは、シフェン酸モノアルキルエステルからなるフラックスである。さらに好けアルステルからなるフラックスである。モルステルからなるフラックスである。モルステルからなるフラックスである。モルステルがらなるの時には、フロン115に対する洗浄性が低下する。また、ジフェン酸のシアルキルエステルではフラックス活性が低くなる。

試験A(ハンダ拡がり率)

病脱酸倒板の表面を研磨し、清浄にした後、150℃の電気炉中で1時間酸化処理した大きさが50×50×0.5 mmの倒板を用意する。この上にJI8 Z-5282に定めるH50A1.6の級状ハンダを直径5 mmの神に巻いて、その一環を切つて作つたハンダリング(0.249)を置く。フランクス試料の約0.059をそのハンダリングの中心部に置き、260℃に加熱する。ハンダの拡がり面積8(ad)をブラニメータによつて効ち。拡がり面積8(ad)をブラニメータによつて水める。

LnP = 4.6 0 5 + Ln (1 - 0.0 7 5 2 8-1)

試験 B (洗浄性試験)

多数個のスルホールを有する網張りブリント回路基板をテストピースとして、これにハンダフラックス試料を約259/m² 強布し、突流式によって共晶ハンダを250で「朝回路面に付ける。 次に、これをフロン113を洗浄剤とする三倍では250の長度超音放洗浄を、第二倍では150の長度洗浄を、第三倍

では蒸気洗浄を各々 2 0 秒間行なり。 洗浄したテストピースは肉眼でフラックス残盗等の有無を観察した後、 これに 8 0 × 1 0 $^{\circ}$ Ω ・ $^{\circ}$ の以上の比抵抗値を有するイソプロベノールと蒸留水の混合液(混合容積比は 7 5 対 2 5)をイオン性残盗の抽出液として、テストピースの表面積 1 0 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 当り 1 6 $^{\circ}$ $^{$

実施例:

表1に示す各種ジフェン酸モノエステルおよび 重合ロジンをイソブロバノールに溶解し、濃度 50重量がの溶液とした。これらをハンダフラッ クス試料とし、試験 A および試験 B によつて評価 した。結果を表1に示す。

表 1

フラックス収料		ながり	先 净 性			
			肉眼観察に込 フラックス残査	抽出核の比抵抗 megobm•Œ		
	ジフエン設 モノイソプロビルエステル	9 6	た し	1 1,4		
本	ジフエン酸 モノ・nープチルエステル	9 5	た し	1 1.7		
発	ジフェン酸 モノイソアミルエステル	9 5	たし	1 3,4		
朔	グフエン酸 モノ-nーヘキンルエステル	9 5	なし	1 6.1		
	ジフエン酸 モノ-2-エチハヘキンハエス テル	9 3	なし	1 5.6		
	ジフェン設 モノラウリハエステル	9 2	なし	1 4.2		
比較	重合ロジン	8 9	全面的に皮膜 状残瘡を認め る。	6.5		

奥施例 2

ジフェン酸モノー2ーエチルヘキシルエステル、ジフェン酸モノラウリルエステル、ジフェン酸モノーローヘキシルエステルおよび重合ロジンに、安2に示す補助剤を各々の10重量多混合したものをイソプロパノールに溶解し、濃度30重量多の溶液とした。これらをフラックス試料として、試験 A および試験 B によつて評価した。結果を安2に示す。

表 2

			ハン	#	产 丹	(性
フラックス飲料		itai. (≸		内設観察化よる フラックス残瘡		
本	グフェン 優モノー ローヘキ シルエス テル	エチルアミン塩酸塩	9	7	僅かに白い公 部分あり	9.6
		ジエチルアミン塩酸塩	9	6	尚上	9.8
		トリエナルアミン塩酸塩	9	6	同上	1 0.1
		イソプロピルアミン塩保塩	9	6	尚上	9.7
1	ジフェン健 モノー2 - エチルへキ シルエス テル	ジエチルアミン塩酸塩	9	7	同上	1 1.5
		ジエナルアミン臭化水素酸塩	9	6	同上	1 2.2
		ツクロヘキシル アミン	9	Z	なし	1 5.1
		シクロヘキシルアミン塩酸塩	9	5	値かに白いい 部分あり	1 4.1
		ラウリルアミン臭化大素の塩	9	4	同上	1 3.4
		モルホリン	9	Z	なし	1 5.2
		モルホリン塩酸塩	9	7	値かに白いシi 部分あり	1 2.5
		ジエタノールアミン臭化水業気性	9	5	同上	1 1.6
	ジエン使 モノラウリル エステル	モルホリン	9	1	なし	1 5.9
		モルホリン塩酸塩	9	5	僅かに白いシミ 部分あり	8.9
比	重合ロジン	ウエチルアミン塩酸塩	 	4	全面的に	2.7
		シクロヘキシルアミン	8	8	皮膜残瘡を認める。	4.5
**		シクローキンルアミン塩酸塩	9	2		3.6
L	<u></u>	モルホリン塩酸塩	,	5		5.9

(発明の効果)

実施例の試験結果のうち、洗浄後のブリント回路基板をイソプロパノールと水の風液で処理した抽出板の比抵抗値は、その値が大きいほど、ブリント回路基板に残存するイオン性の残液量が少ないことを示す。したがつて、このことはフロン113によるフラックスの洗浄性が高いことを意味する。また、ハンダ拡かり率は、その値が大きいほど、フラックス活性が高く、ハンダ付け性がよいことを示す。

実施例の結果から明らかなように、本発明のフラックスは、ハンダ付け性とフロン 1 1 3 による洗浄性が優れており、産業上極めて有用なものである。とりわけ、電子部品を開張りプリント回路 基板へハンダ付けする際に利用価値が高い。

(参考文献)

特別的 4 7 — 7 9 1 3、同 4 9 — 9 7 7 5 0、同 4 9 — 1 2 6 5 4 5、同 5 0 — 2 0 9 5 7、问 5 0 — 2 0 9 5 7、问 5 0 — 2 0 9 5 1

手統補正菌 (6%)

昭和62年1月29日

特許庁長官 無田 明雄 殿

- 1 事件の表示 特額町61-278820身
- ,2 発明の名称 ハンダフラックス
- 3 補正をする者事件との関係・特許出額人(003)組化成工業株式会社
- 4 代理人 東京都港区成ノ門一丁目2番29号成ノ門産業ビル5階 (6823) 弁理士 済水 ない
- 5 補正の対象 明細ආの発明の詳細な説明の概



- 4 4 5 7 5、同 5 2 - 1 5 2 8 4 6、同 5 6.-5 4 7 9 8、同 5 6 - 5 4 7 9 9、同 5 6 --1 0 9 2 9 8、同 5 6 -- 1 0 9 2 99、同 5 9 --2 2 9 2 9 6。

代理人 清水



6 補正の内容

明細書の記載を下記のとおり補正する。

- (2) 第 8 頁の扱 1 ⇒ L び 第 1 0 頁の表 2 中の 「megohm・cm」を 「1 0 ° Ω・cm」と補正する。

代理人 倩 水

